産学官連携戦略的技術マップの提案

ブラットパネル・ディスプレイを題材 とした実証的分析について

2004年10月15日

神戸大学経済経営研究所政策研究リエゾンセンター 森田 弘一

問題意識

- 企業が、製品開発のダイナミズムの中で、市場競争力(産業競争力)を強化・維持していくためには、コア・コンピタンスの強化とともに多様な技術戦略を追求することが重要。
- このような要請に対応しうる新たな産学連携 手法として、大学の多様なR&D活動(能力) を、個々の製品開発に「柔軟に」連携させる ことを考えてみる。

進め方

- 企業の潜在的R&Dニーズを抽出し、それに対応しつる大学側の技術シーズ(要素技術)を進行度区分で整理した「戦略的技術マップ」を作成する。
- 大学の産学連携リエゾン部局を介した学内の技術シーズの探索と、これらを大学間で共有することによる効果及び意義について考える。

実証分析対象の設定

なぜフラットパネルディスプレイか

- 市場の著しい成長と比較的明確な製品 ニーズの下での激しいR & D競争
- 有力技術の並立(液晶、有機EL、プラズマ、その他)と、そのそれぞれに関する、要素技術から製造技術に至る「厚み」と「裾野」の大きさ
- 企業側のR&D資源の戦略的配分の必要性と、大学側の多様な関与の可能性

調査方法 その1 製品側からのR&Dニーズ抽出

- 大学との連携を期待する分野の提示
 - 液晶関連:17項目 有機EL関連:14項目
 - プラスマ関連:9項目 共通的事項等:2項目
- 大学の技術シーズを抽出しやすいような 性能概念の提示
- 解決すべき課題(性能との関係)の提示
- 必要な「イノベーションのタイプ」の提示

調査方法 その2 **大学の対応状況の整理**

■ R & Dニーズごとに、対応する大学の研究活動を「進行度区分」で提示 材料・基本原理の探索 デバイス・アーキテクチャの設計 工法・製法の探索 評価手法の確立・実施

R & Dニーズへの適合性の程度を提示

製品分野別回答項目数

分野	Α	В	小計	A比率
液晶パネル	32	63	95	0.34
有機ELパネル	47	60	107	0.44
プラズマパネル	4	15	19	0.21
共通・その他	7	15	22	0.32
全体	90	153	243	0.37

A:R&Dニーズへの適合度が高いもの

B:R&Dニーズへの適合可能性があるもの

対応状況(区分)別回答項目数比率

	大学の対応状況(区分)							
分野	材料·基本 原理の探 索	デバイス・ アーキテクチャ の設計	工法·製法 の探求	評価手法 の確立・実 施				
液晶パネル	0.42	0.18	0.25	0.15				
有機ELパネル	0.37	0.22	0.23	0.17				
プラズマパネル	0.63	0.05	0.16	0.16				
共通・その他	0.59	0.14	0.23	0.05				
全体(平均)	0.43	0.19	0.23	0.15				

フラッ	<i>ラットパネルディスプレイ</i> 戦略的 技術マップ (近畿地区関係大学総括表: 5 0音順に記載						.載)													
製品側からの		品側からの 大学の対応状況							讨応状況				製品側からの							
分野		R & Dニーズ	大阪大学	大阪工業大学	大阪府立大学	関西大学	京都大学	京都工芸繊維大学	近畿大学	神戸大学	同志社大学	奈良女子大学	奈良先端科学 技術大学院大学	兵庫県立大学	立命館大学	龍谷大学	和歌山大学	R & D ニース	(分野
		項目	ア <mark>ィ</mark> ゥェ	ア <mark>ィ</mark> ゥェ	ア <mark>イ</mark> ウェ	ア <mark>イ</mark> ウエ	ア <mark>ィゥェ</mark>	ア <mark>ィ</mark> ゥェ	ア <mark>イゥエ</mark>	ア <mark>ィ</mark> ゥェ	ア <mark>ィゥェ</mark>	ア <mark>イウェ</mark>	ア <mark>ィゥェ</mark>		ア <mark>イ</mark> ウエ	ア <mark>ィ</mark> ゥェ	ア <mark>ィゥェ</mark>	項目		
対		直配向式(MVA)																垂直配向式(MV	A)	
4 H	" 水	(平配向式(IPS)																水平配向式(IP:	表示(分子)	
表示(分子) モード	į la	はい式(TN)																ねじれ式(Ti	(A	
	7	の他 (新方式)																その他(新方式)	
77	-	プモルファスSi/低温ポリSi																アモルファスSi/低温ポリSi	75	
4	Ŀ	結晶Si/有機TFT																結晶Si/有機TFT -	4 4	
液が	Т	FD																TF	D 7	
液ű	7	の他 (新方式)																その他(新方式) "\	液晶
パ	偏	3光板 / 位相差板																偏光板 / 位相差	板	バ
オルシェ	色	色制御(フィルタ等)																色制御(フィルタ等		ネル
光光量	ׅ֡֟֝֟֝֓֞֝֟֝֓֡֡֡֡֡֡֝֞֝֓֡֡֡֝֡֡֡֝֡֡֡֡֡֡֝֡֡֝֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡	冷陰極管式																冷陰極管式	光量等	
是利用效率	3	LED式																LED式	等地経路技術	
<u> </u>	7	有機EL式																有機EL式 ユ		
	7	その他(新方式)																その他(新方式)	<i>-</i>	
**	УZ	フトウエア(アルコ゚リス゚ム等)																ソフトウエア(アルコ゚リス゚ム等) #	
表示駆動	信	号制御システム/回路設計																信号制御システム/回路設	計響	
動	97	ステムディスプレイ設計																システムデ・ィスフ・レイ設	計	
米		低分子																低分子、		
発光材料	凶を対	高分子																高分子	発光材料	
	华	燐光																烘光 烘光	立 2	
デバイ	蕭	薬 トップエミッション構造																トップ・エミッション構造 富	アパイ	
イス	心然	ド 高効率光取り出し構造																高効率光取り出し構造 ³	イスト	
7、構造	そ	の他(新方式)																その他(新方式	ス構造	有機
E ų	1 -	ヲモルファスSi/低温ポリSi																アモルファスSi/低温ポリSi -	1 7	
トがが	T 1	□ ————————————————————————————————————																ーーニー ¬ 結晶Si/有機TFT ¬	クラックラ	
パネ		の他(新方式)																その他(新方式	,	ネ
U (B)	+	原色直接発光																三原色直接発	光郎	ル
色制御	-	色 + カラーフィルタ等																単色 + カラーフィルタギ	- #	
	y	フトウエア(アルゴリズム等)																ソフトウェア (アルコ・リス・ム等) الله	Ť.
表示駆動	\vdash	信号制御システム / 回路設計																信号制御システム/回路設	XIII	
区動	-	ステムデ・ィスフ・レイ設計																システムテ・ィスフ・レイ記録	IXI	
	1.	駆動方式(紫外線放射)																駆動方式(紫外線放射)		
故書	Xe Z	世 世 世 世 世 世 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日																蛍光体(可視光発光)	被馬	
プー	/ ※	セル構造																セル構造	м Н	7
ラーで	新	f方式(非Xeガス系)																新方式(非Xeガス系	7.	プラ
ス —	t	zル表面(プラス゚マ界面)制御																セル表面(プラズマ界面)制		ママ
ズマパネル プロス	#	(光体劣化制御				 												蛍光体劣化制	J. 170	マパネル
イスは	T L	プ形成制御				 					1	1	1					リプ形成制	四大品	イル
		ドレス/表示分離型(ADS)				 												アドレス / 表示分離型(AD:	C)	-
表现	: H	行方式				 							1					新方:		
# 71/2		ブル化(衝撃対応)				1			\vdash		1	1								++
通エル	ゴノ	ミックス (人間工学)				 					<u> </u>		1					フレキシブル化 (衝 エルゴノミックス (人	間工学)	共通
		「対応状況」の記号に	ついて	<u>ー</u> ア:材料	I 料・基本原	<u> </u> 理の探索		\` イス・アーキテク	チャの設計		<u>.</u>	<u> </u> 工程・製法	 去の探索 :	<u>l</u> 工:評価手	法の確立・	実施		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,_, <i>,-</i> ,	

イノペーション特性との関係からみた回答項目数

分野	А	В	小計	A比率
革新的イノペーション が求められるもの (製品化が困難)	37	80	117	0.32
全体	90	153	243	0.37

A:R&Dニーズへの適合度が高いもの B:R&Dニーズへの適合可能性があるもの

イノヘーション特性との関係からみた 対応状況(区分)別回答項目数比率

	大学の対応状況(区分)							
分野	材料·基本 原理の探 索	デバイス・ アーキテクチャ の設計	工法·製法 の探求	評価手法 の確立·実 施				
革新的イノペーション が求められるもの (製品化が困難)	0.44	0.18	0.18	0.25				
全体(平均)	0.43	0.19	0.23	0.15				

「技術マップ」から読み取れるもの

- 産学連携研究に対する企業側の潜在的 なニーズ(期待)
- 大学研究者の関心の所在
- 「製品側からのR&Dニーズ」への「大学 の研究活動」の対応可能性
- 特定の製品分野に関連する「技術基盤」 の構築状況

誰のための「技術マップ」か

- より戦略的な産学連携R&D活動とは、 製品開発において「本質的」に存在する 企業と大学の認識ギャップを、柔軟かつ 合理的に埋めることのできるスキームに 基づくものであることが重要である。
- どのような目的・意義において、誰が「技術マップ」を構築するのか。